

Лекция 2. Детекторы

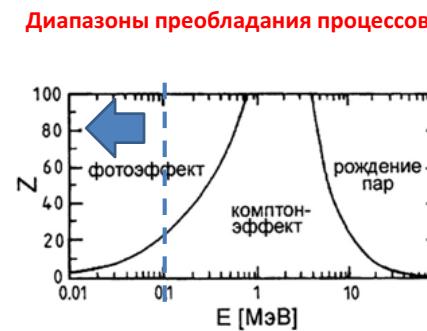
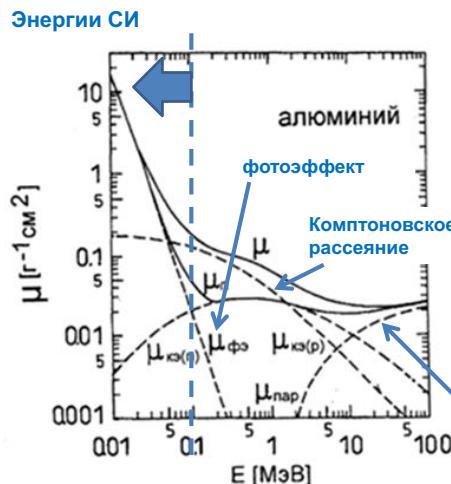
- 1) Механизмы взаимодействия фотонов и нейтронов с веществом
- 2) Взаимодействие заряженных частиц (вторичного излучения) с веществом
 - Электроны
 - Тяжелые частицы: p , α ...
- 3) Детекторы
 - Типы и особенности
 - Режимы работы
- 4) Базовые характеристики детекторов
 - Эффективность регистрации
 - Энергетическое разрешение
 - Пространственное разрешение
 - Временные характеристики

Механизмы регистрации фотонов

Полный коэффициент ослабления

При прохождении пучка через вещество полный коэффициент ослабления – есть сумма всех эффектов

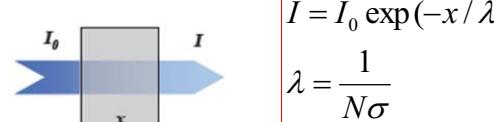
$$\mu = \mu_{\text{ФЭ}} + \mu_{\text{КР}} + \mu_{\Pi} \quad \mu = 1/\lambda$$



Онлайн база данных:
http://www.nist.gov/pml/data/xray_gammaRay.cfm

Основные процессы взаимодействия

При взаимодействии фотона с атомом, он либо поглощается либо рассеивается на большой угол



x : Толщина материала

λ : Длина своб. пробега

σ : Полное сечение взаимодействия

N : Концентрация в-ва

3 основных канала взаимодействия фотонов

- Фотоэффект $E_\gamma \rightarrow E_K - E_L$ Сечение каждого механизма взаимодействия существенно зависит от энергии фотона
 $E_\gamma < 100$ кэВ
- Комптоновское рассеяние $E_\gamma \rightarrow E_C - E_e$ θ_C θ_e E_γ до 1 МэВ
- Образование пар $E_\gamma \rightarrow e^+ - e^-$ $E_\gamma > 1$ МэВ

ФЭ: Эмиссия вторичного электрона



При энергии у-квантов существенно большей энергии связи электронов в атоме можно считать, что рассеяние фотонов происходит на свободных электронах.

2) средние энергии: $E_\gamma \approx 1 \text{ МэВ}$ ($E_\gamma \gg W$)

Комптоновское рассеяние: $\gamma + e^- \rightarrow \gamma' + (e^-)'$ (рассеяние фотона)

энергия фотона: $E_e = h\nu - h\nu'$

$$v'/v = \frac{1}{1+k(1-\cos\theta)}$$

$$\text{или } \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_\gamma}$$

энергия электрона: и угол эмиссии

$$E_e = h\nu \frac{k(1-\cos\theta)}{1+k(1-\cos\theta)}$$

$$\operatorname{ctg}\phi = (1+k)\operatorname{tg}(\theta/2), \quad k = \frac{h\nu}{m_e c^2}, \quad \text{Для высоких энергий}$$

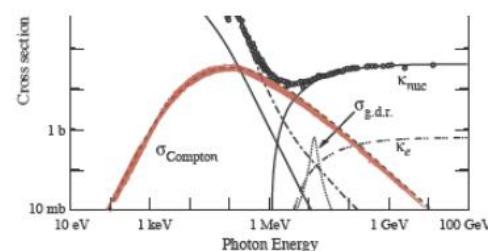
$$E_e(\min) = 0 \quad (\phi = \pi/2, \theta = 0)$$

$$\sigma_{\text{KP}} \sim \frac{\ln(E_\gamma) Z}{E_\gamma} \Rightarrow E_\gamma \gg m_e c^2 \quad \sigma \sim \frac{\ln(k)}{k} Z$$

$$E_e(\max) = \frac{2k^2}{1+2k} \quad (\phi = 0, \theta = \pi)$$

Для низких энергий часто применяется формула Клейна-Нишина

$$E_\gamma \ll m_e c^2 \quad \sigma \sim 1 - 2k$$



Регистрация фотонов

ЭНЕРГИЯ ФОТОНОВ - Определяет основной механизм взаимодействия

1) низкие энергии: $I_0 < E_\gamma < 100 \text{ кэВ}$

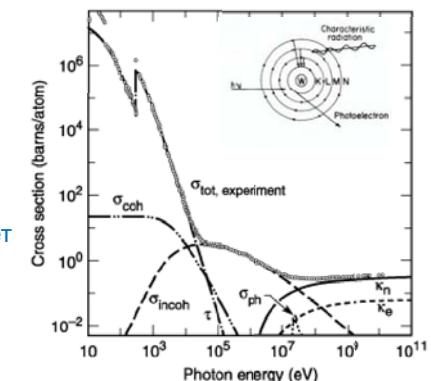
Фотоэффект: $\gamma + \text{атом} \rightarrow \text{атом}^+ + e^-$ (поглощение фотона)

$$E_e = E_\gamma - W(K, L, \dots),$$

W – энергия связи электрона K, L, ... - оболочки

A) $\sigma_{\text{ФЭ}} = \text{const} \frac{Z^5}{E_\gamma^{7/2}}$ $W < h\nu < m_e c^2$

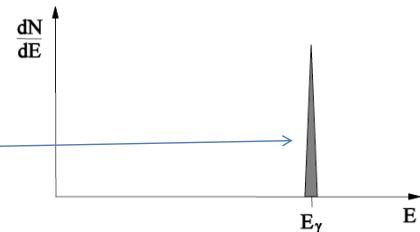
Б) $\sigma \sim Z^5 / E_\gamma \quad h\nu > m_e c^2$



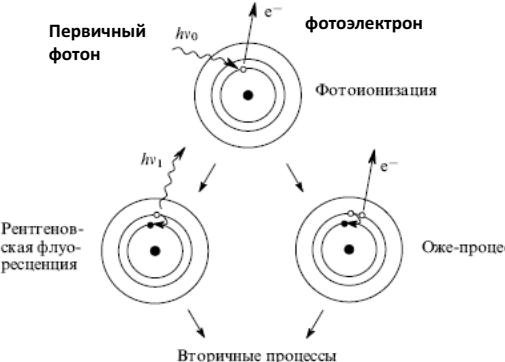
ФЭ может идти на любой атомной оболочке, но если энергия фотона превышает энергию связи на K-оболочке ($W(K)$), то ФЭ идет преимущественно с вырыванием K-электрона.

Амплитудный спектр ФЭ

- Фотоэлектрон обычно поглощается в детекторе на коротких расстояниях, т.е. имеет малую длину свободного пробега.
- Если вся энергия электрона поглощается детектором, то на амплитудном спектре мы должны увидеть узкий «фото-пик»
- Однако вторичные процессы «портят» картину



Снятие возбуждения с атома



1) **Оже эффект** – безызлучательный процесс с испусканием электрона

$$E_e(\text{Оже}) = E_K - E_{L1} - E_{L2} \quad \text{для перехода } KL_1 L_2$$

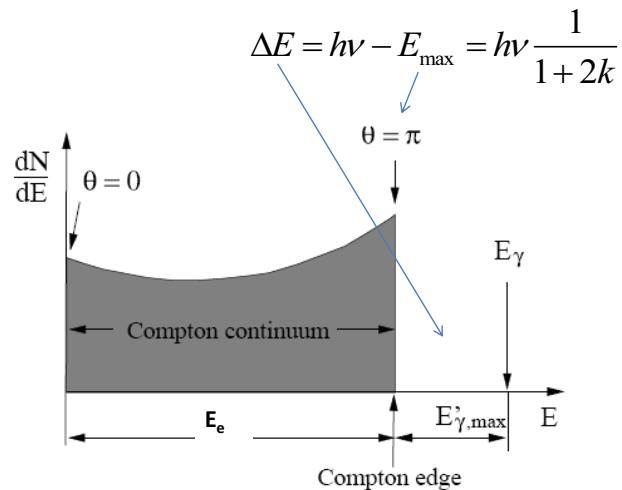
$$E_e(\text{Оже}) = 50-3000 \text{ эВ} (\sim E_{\text{связи}})$$

2) **Флуоресценция** – испускание гамма-кванта(-ов) с характерной энергией для данного вещества

$$h\nu_1 = E_1 - E_2$$

Спектр КР – непрерывный, т.к. фотон многократно рассеивается до поглощения

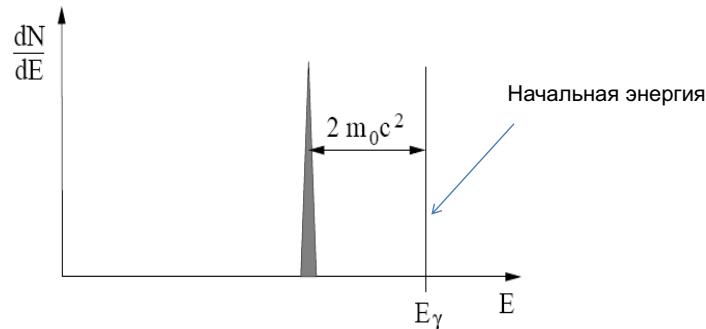
- При КР часть энергии всегда уносит фотон.
- Поэтому если фотон полностью не поглотится в детекторе, то часть его энергии будет утеряна.



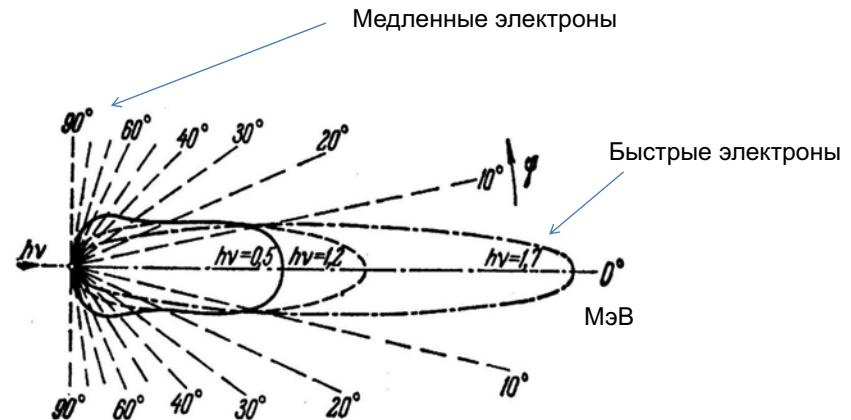
Из закона сохранения энергии также следует, что при рождении электрон-позитронной пары суммарная энергия, которая может быть зарегистрирована составляет

$$E = h\nu - 2m_e c^2 = E^+ + E^-$$

Спектр Э/П пар при поглощении обеих частиц



КР: Угловое распределение вторичных электронов



Рождение электрон-позитронных пар происходит в электрическом поле ядер, при этом фотон исчезает, а его энергия передается электрону, позитрону и ядру (энергия отдачи).

Рождение пар : $\gamma + \text{ядро} \rightarrow e^+ + e^- + \text{ядро}$ (поглощение фотона)

Из закона сохранения энергии (пренебрегая энергией, переданной ядру):

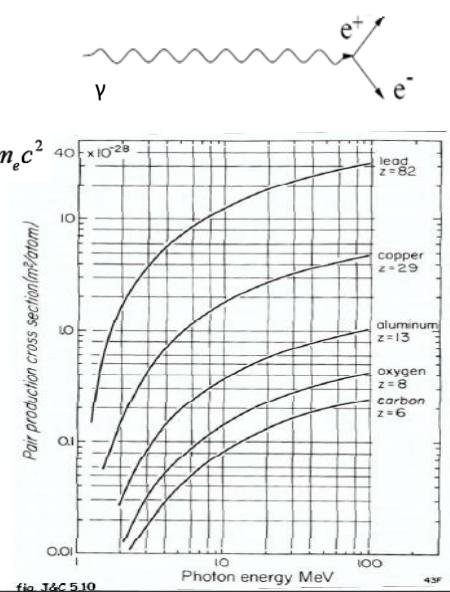
$$h\nu = E_{\text{пар}}(-) + E_{\text{пар}}(+) = E_{\text{ядра}}(-) + E_{\text{ядра}}(+) + 2m_e c^2$$

поэтому энергетический порог реакции

$$E_\gamma > 2m_e c^2 = 1.022 \text{ МэВ:}$$

$$\sigma_{\text{ЭП}} \sim Z^2 \left(c_1 \ln \frac{c_2}{Z^{\frac{1}{3}}} - c_3 \right)$$

c_i - константы

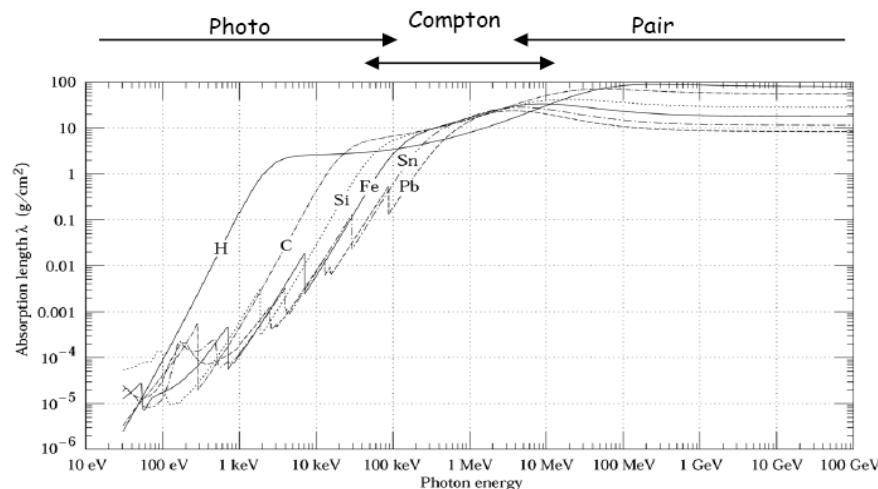


Длина свободного пробега фотонов

Ослабление пучка фотонов в веществе $I = I_0 \exp(-\mu x)$

$$\text{Массовый коэффициент ослабления } \mu = \frac{N_a}{A} \sum_i \sigma_i \quad (\text{см}^2/\text{г})$$

Толщина поглотителя $\{x\}=\text{г}/\text{см}^2$, длина своб. пробега $\lambda = 1/\mu$



Поглощенная энергия фотонов может идти на

1) ионизацию:

- образование электрон-ионных пар (20-40 эВ)
- электронов и дырок в п/п (1-5 эВ)

2) Возбуждение атомов с эмиссией фотонов (~ 20 эВ)

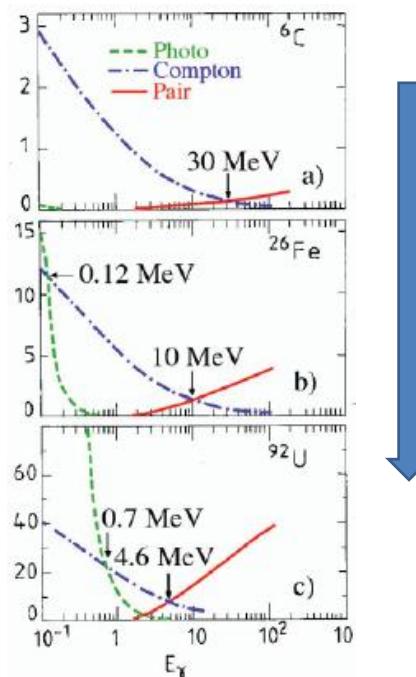
3) Генерацию фононов ($\sim \text{мэВ}$):

- вибрация крист. решетки и нагрев поглощающего материала

4) Химические реакции в поглощающем материале

Все эти эффекты могут применяться для регистрации фотонов!

Зависимость сечений от Z



$$\begin{aligned} \text{ФЭ: } & \sigma \sim Z^5 \\ \text{КР: } & \sigma \sim Z \\ \text{ЭПП: } & \sigma \sim Z^2 \end{aligned}$$

Для регистрации фотонов
выгодно применять
материалы с высоким Z !

Z

Толщина детектора и энергия фотонов

Количество поглощенных фотонов

$$f = 1 - \exp(-\mu x)$$

10 кэВ фотоны в Si:

$$\mu = 10^2 \text{ см}^{-1}$$

$$x = 300 \text{ } \mu\text{м}$$

$$\mu x = 3, f = 0.95$$

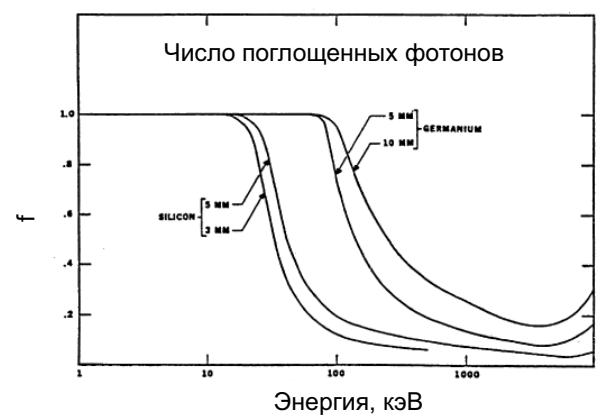
(Фотопоглощение)

1 МэВ фотоны в Si:

$$\mu = 10^{-1} \text{ см}^{-1}$$

$$x = 30 \text{ мм}$$

$$\mu x = 3, f = 0.95$$



Энергия, кэВ

→ Эффективность выше для Ge (выше Z)

(Комптоновское рассеяние)

Ядерные реакции, применяемые для регистрации нейтронов

I. Реакции (n, p) , (n, α) $\sigma \sim 1/v$

- 1) ${}^3\text{He} + n \rightarrow p$ (573 кэВ) + T (191 кэВ) $\sigma = 5333$ барн для $E=0.025$ эВ ($\lambda=1.8$ Å)
 $\sigma = 5333$ барн
- 2) ${}^6\text{Li} + n \rightarrow \alpha$ (2.05 МэВ) + T (2.75 МэВ) $\sigma = 940$ барн
- 3) ${}^{10}\text{B} + n \rightarrow {}^7\text{Li}^* + \alpha \rightarrow {}^7\text{Li}$ (0.83 МэВ) + α (1.47 МэВ) + γ (0.48 МэВ) (93%)
 $\rightarrow {}^7\text{Li}$ (1.0 МэВ) + α (1.8 МэВ) (7%)
 $\sigma = 3837$ барн

II. Реакции радиационного захвата (n, γ)

- 4) ${}^{155}\text{Gd} + n \rightarrow {}^{156}\text{Gd}^* \rightarrow {}^{156}\text{Gd} + x^*\gamma + 7.9$ МэВ → конв. эл-ны: 39-199 кэВ
 $\sigma \sim 60900$ барн
- 5) ${}^{157}\text{Gd} + n \rightarrow {}^{158}\text{Gd}^* \rightarrow {}^{158}\text{Gd} + x^*\gamma + 8.5$ МэВ → конв. эл-ны: 29-182 кэВ
 $\sigma \sim 254000$ барн

III. Деление тяжелых ядер (n, f)

- 6) ${}^{235}\text{U} + n \rightarrow$ фрагменты распада + 80 МэВ $\sigma = 583$ барн
- 7) ${}^{239}\text{Pu} + n \rightarrow$ фрагменты распада + 80 МэВ $\sigma = 748$ барн

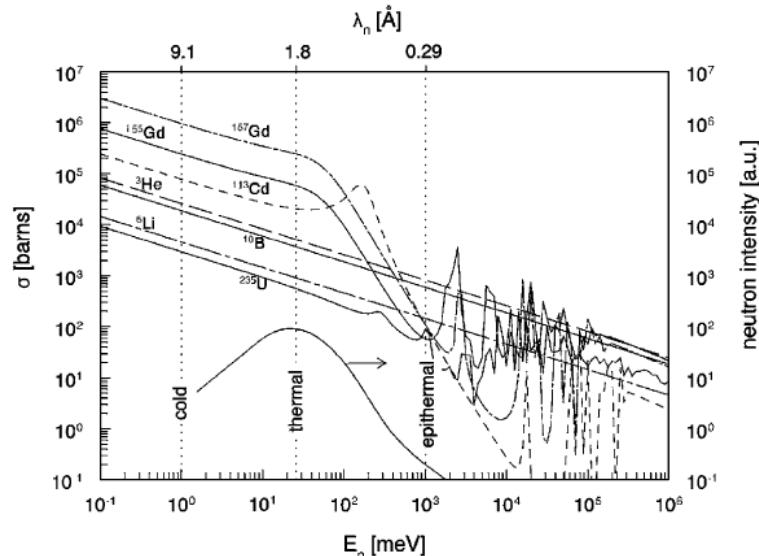
Для регистрации БН используется упругое/неупругое рассеяние п на ядрах

Вторичное излучение при конверсии частиц:

- СИ: электроны, фотоны, ..
- Нейтроны: электроны, p, α , ..., ядра отдачи, фотоны

Механизмы регистрации нейтронов

Зависимость сечений некоторых реакций от энергии нейтронов



См. также:

<http://www.nndc.bnl.gov/exfor/endf00.jsp>
http://www.kayelaby.npl.co.uk/atomic_and_nuclear_physics/4_7/4_7_2.html

Ф-ла Бете-Блоха: основные следствия и закономерности

- Справедлива для тяжелых частиц $M \gg m_e$
- Ионизационные потери энергии зависят от скорости налетающей частицы и не зависят от ее массы
- в первом приближении среда характеризуется отношением Z/A (т.е. электронной плотностью вещества)



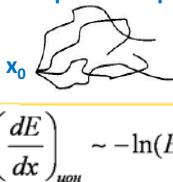
Электроны: Могут потерять до половины энергии при соударениях с электронами атомов и рассеяться на большие углы

1) Потери на ионизацию и возбуждение атомов:

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ион.}} = -\frac{2\pi}{\beta^2} n_e r_0^2 m_e c^2 \left[\ln \left(\frac{m_e c^2 T_e}{I^2} \frac{\beta^2}{2(1-\beta^2)} \right) - (2\sqrt{1-\beta^2} - 1 + \beta^2) \ln 2 + 1 - \beta^2 \right],$$

$m_e c^2 = 511 \text{ кэВ}$ - энергия покоя электрона,
 I - средний ионизационный потенциал атомов среды : $I=13.5*Z \text{ эВ}$

Траектория электрона



$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ион.}} \sim -\ln(E)$$

2) Потери на тормозное излучение при кулоновском рассеянии на ядрах – существенный вклад в отличие от тяж. частиц!

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{рад.}} = -\frac{16}{3} n E \frac{Z^2 r_0^2}{137} \quad E \ll m_e c^2 = 511 \text{ кэВ}$$

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{рад.}} = -n E \frac{Z^2 r_0^2}{137} \left(4 \ln \frac{183}{Z^{1/3}} + \frac{2}{9} \right) \quad E/m_e c^2 \gg 137/Z^{1/3}$$

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{рад.}} = -n E \frac{Z^2 r_0^2}{137} \left(4 \ln \frac{2E}{mc^2} - \frac{4}{3} \right) \quad 1 \ll E/m_e c^2 \ll 137/Z^{1/3}$$

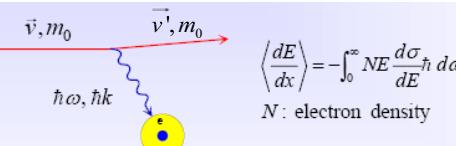
3) Суммарные потери энергии

$$\left(\frac{dE}{dx} \right) = \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ион.}} + \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{рад.}}$$

Радиационные потери малы для легких элементов в широком диапазоне энергий, а для тяжелых, например, Pb радиационные потери преобладают уже при $E \sim 10 \text{ МэВ}$

Взаимодействие заряженных частиц с веществом

Неупругие столкновения частиц с электронами атомных оболочек поглотителя



Потери энергии на упругие соударения (кул. расс. на ядрах) невелики, но приводят к разбросу направления движения частиц.

2 основных канала потерь энергии:

- Возбуждение атомов (переход электронов на вышележащую оболочку),
- ионизация (вырывание электрона с ат. Оболочки)

Ионизационные потери энергии ф-ла Бете-Блоха для тяжелых частиц:

$$\left(\frac{dE}{dx} \right) = -4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 Z \frac{1}{A \beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2m_e c^2 \gamma^2 \beta^2}{I^2} T_{\max} - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right] \quad \left(\frac{\text{МэВ см}^2}{\text{г}} \right)$$

N_A – число Авогадро ($6.022 \cdot 10^{23}$ моль $^{-1}$)

$\beta = v/c$, I – средний потенциал ионизации

$T_{\max} = 2m_e v^2$ – максимальная энергия передаваемая электрону

A, Z – атомный вес и номер поглотителя $Z/A \sim N_e$ – электронная плотность среды

ze – заряд налетающей частицы

$r_e = e^2 / 4\pi\epsilon_0 m_e c^2$ – классический радиус электрона

δ – эффект плотности (для высоких энергий)

Для составного вещества:

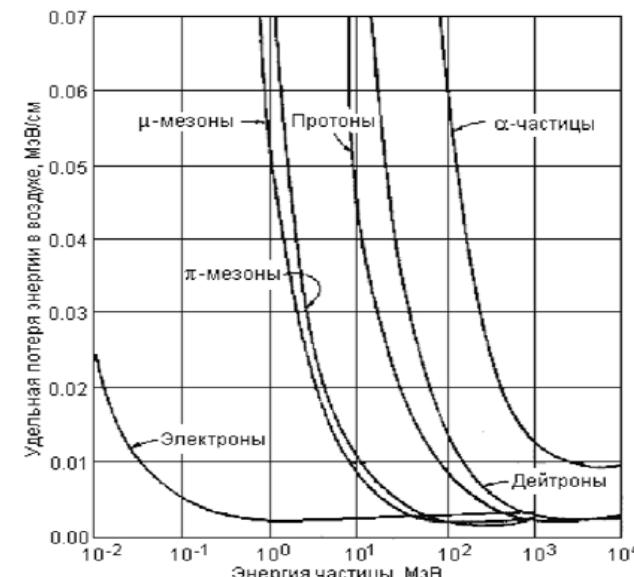
$$\frac{dE}{dx} = \sum w_i \left(\frac{dE}{dx} \right)_i$$

Налетающая частица

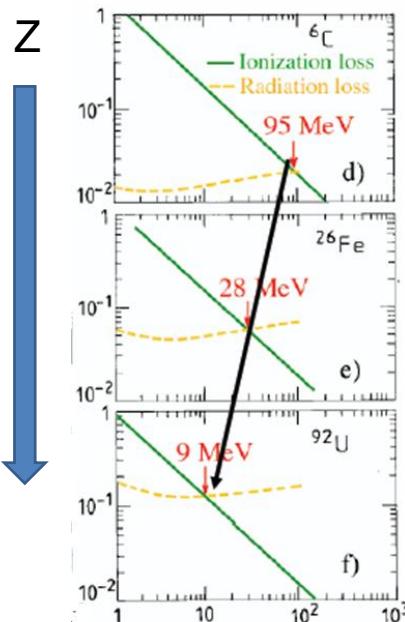
Среда

Физические постоянные

Потери энергии частицами в воздухе



Зависимость от Z и E, примеры



Основные механизмы потерь энергии для e^-
 • ионизационные потери
 • потери на тормозное излучение

Критическая энергия электронов

$$\frac{dE}{dx} (\text{ion}) = \frac{dE}{dx} (\text{rad})$$

$$\epsilon_c \propto 1/Z$$

Критическая энергия электронов

$$k = \frac{(dE/dx)_r}{(dE/dx)_c} \approx \frac{EZ}{1600mc^2}$$

$$E_c = E : k = \frac{(dE/dx)_r}{(dE/dx)_c} = 1$$

$$E_c = \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1.24} \quad (\text{тв. и жидк. фаза}) \quad E_c = \frac{710 \text{ MeV}}{Z + 0.92} \quad (\text{Газы})$$

В области энергий, в которой преобладают радиационные потери, энергия электронов экспоненциально убывает при прохождении через вещество:

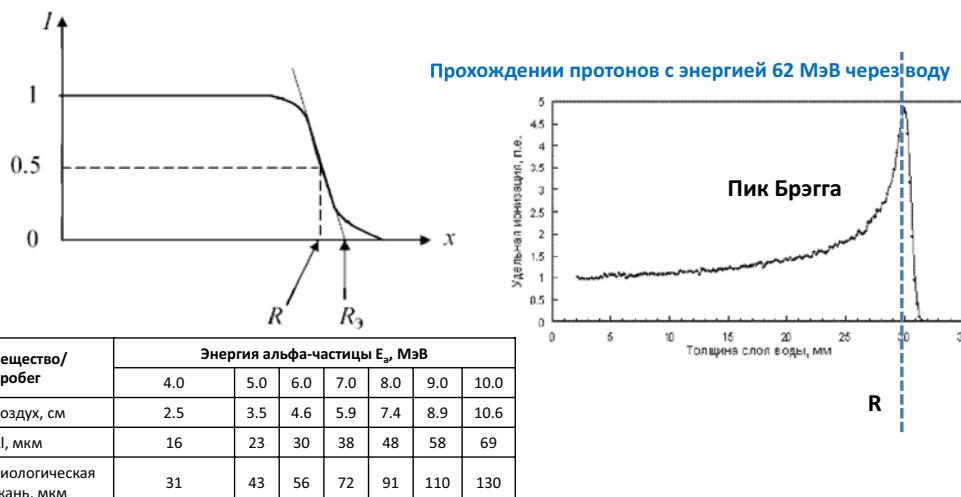
$$E = E_0 \exp(-x/L_r),$$

L_r – радиационная длина

Вещество	Критическая энергия E_c , МэВ	Радиационная длина L_r	
		г/см ²	см
H	340	63.1	$7 \cdot 10^5$
C	103	42.7	19.4
Воздух	83	36.2	$3 \cdot 10^4$
Al	47	24	8.9
Fe	24	13.8	1.77
Cu	21.5	12.9	1.4
Pb	6.9	6.4	0.5

Пробег тяжелых частиц

- В силу статистических флуктуаций пробег тяжёлой частицы R определяется как расстояние, на котором интенсивность пучка частиц составляет половину от начальной интенсивности.
- Экстраполированный пробег R_s – расстояние, на котором прямая, аппроксимирующая средний участок спада кривой интенсивности, пересекает ось x

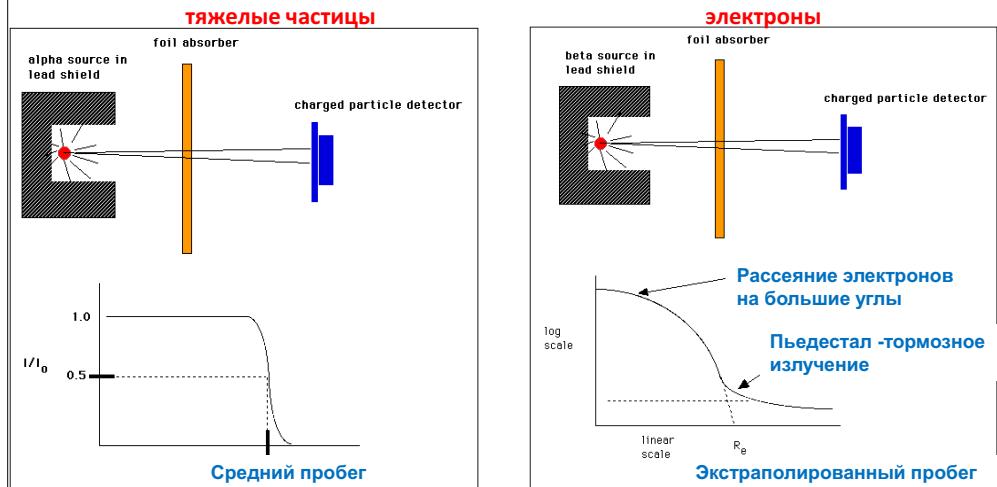


Пробеги заряженных частиц

Средний пробег частицы с начальной энергией E_0 :

$$R(E_0) = \int_0^{E_0} \frac{dE}{dE/dx}$$

Прохождение тонкого пучка частиц через слой поглотителя



Детекторы

- По типу преобразования поглощенной энергии в сигналы:

- ионизационные - детектируемое излучение образует электрон-ионные пары (эл-дырки) в рабочем веществе детектора, которые собираются на электродах и преобразуются в сигнал
- радиолюминесцентные (в т.ч. сцинтиляционные) - в веществе под действием ионизирующего излучения возникает люминесценция, которая регистрируется детектором

- По типу детектирующей среды:

- газонаполненные
- жидкие
- твердотельные - п/п, сцинтилляторы

Экстраполированный пробег электронов

- Электроны имеют большой разброс пробегов
- Поэтому в качестве средней величины пробегов используют понятие **экстраполированного пробега** - такая толщина поглотителя, при которой продолжение линейно спадающего участка зависимости интенсивности электронного пучка $I(x)$ пересекает уровень нулевой интенсивности

R_e (г/см²) в алюминии:

$$R_3(\text{Al}) = 0.4E^{1.4} \text{ при } E < 0.8 \text{ МэВ},$$

$$R_3(\text{Al}) = 0.54E - 0.133 \text{ при } E > 0.8 \text{ МэВ.}$$

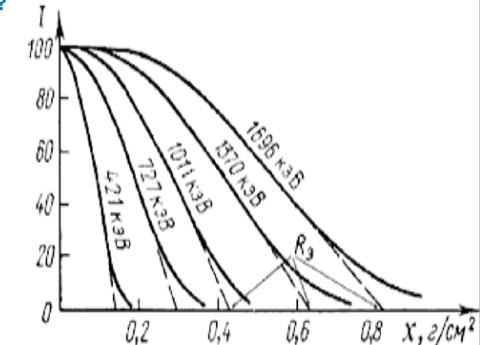
Спад интенсивностиmonoэнергетического пучка электронов от толщины алюминиевого поглотителя для разных энергий электронов

Как рассчитать пробег для произвольного вещества?

R_e в веществе (Z, A) можно выразить:

$$R_3(A, Z) = R_3(\text{Al})(Z/A)_{\text{Al}}/(Z/A).$$

Вещество	Энергия электронов, МэВ				
	0.05	0.5	5	50	500
Воздух	4.1	160	$2 \cdot 10^3$	$1.7 \cdot 10^4$	$6.3 \cdot 10^4$
Вода	$4.7 \cdot 10^{-3}$	0.19	2.6	19	78
Алюминий	$2 \cdot 10^{-3}$	0.056	0.95	4.3	8.6
Свинец	$5 \cdot 10^{-4}$	0.026	0.30	1.25	2.5



Детектор



- По методу представления информации:

фотографического типа - изображение (координата, интенсивность)

- + высокая загрузка, пространственное разрешение, большие площади регистрации произвольной формы и кривизны
- дискриминация фонового излучения (?), обработка изображений, отсутствие временной информации, отсутствие on-line контроля измерений

электронного типа - сигнал (координата, интенсивность, энергия, время)

- + вариативность методов съема сигналов и их обработки, идентификация частиц по форме сигнала
- для достижения высокого быстродействия необходима сложная многоканальная электроника, дорогие в изготовлении и обслуживании

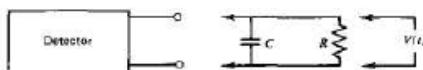
Счетчики частиц

- Детектор считает каждое событие отдельно.
- Например, газоразрядные детекторы такие как MWPC, MSGC **обычно мало чувствительны к шуму** – есть возможность фильтрации каждого события по амплитуде сигнала.
- Однако, счет событий приводит к возникновению мертвого времени, в течение которого детектор не регистрирует события
 - время формирования сигнала
 - работа считывающей электроники
- **Быстродействие счетчиков ухудшается при повышении загрузки** – возникают просчеты и необходимость коррекции на мертвое время при измерении интенсивности излучения. Это не всегда просто например для синхротронов – необходимо учитывать структуру импульса фотонов.

Динамический диапазон счетчиков составляет до 10^6 .

Снизу ограничен числом ложных срабатываний, а сверху мертвым временем системы.

2. Импульсный режим – регистрация каждого события и его энергии

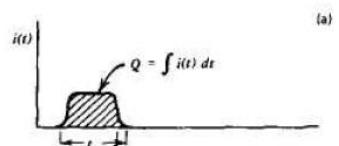


Ток на выходе д. преобразуется с импульс напряжения с помощью усилителя

C – эквивалентная емкость д. и усилителя

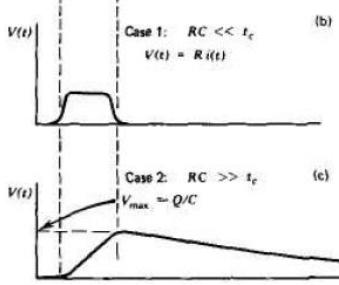
R – входное сопротивление усилителя

$t = RC$ – характеристическое время, определяет форму импульса



- $t << t_c$ - форма выходного сигнала $V(t)$ повторяет форму тока, протекающего в детекторе

Применяется в детекторах, где требуется высокая скорость счета и быстродействие. При этом энергетическое разрешение хуже.



- $t > t_c$ - напряжение растет до максимального и в момент t_c достигает $U_{max} = q/C$, затем спадает до нуля если нет второго импульса.

Т.о. амплитуда сигнала пропорциональна поглощенному заряду.

спектрометрия

2 категории детекторов: интегрирующего типа и счетчики

Характеристики детекторов интегрирующего типа (CCD, Image Plates и пленка) **больше подходит для высоких загрузок**, когда роль внутреннего шума детектора снижается.

Шум обусловлен:

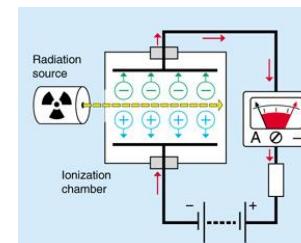
- флуктуациями измеряемой величины (заряд ионизации, количество фотонов в сцинтилляторе)
- темновой шум (внутренний шум детектора - шум без облучения)
- шум считывающей электроники

В CCD, например, шум считывающей электроники линейно зависит от частоты снимков. Уровень этого шума существенно выше темнового шума. Частота снимков в свою очередь связана с интенсивностью излучения.

При некоторой пороговой величине интенсивности интегратор входит в насыщение, т.е дальше нельзя копить информацию.

Динамический диапазон интегрирующих систем ограничен шумом и уровнем насыщения и обычно составляет 10^4 - 10^5 .

Счетный и токовый режим работы детектора



t_c – время сбора зарядов в рабочем объеме детектора:

$t_c \sim \text{нс}$ (π/ρ , ФЭУ)

$t_c \sim \text{мс}$ (ионизационные камеры)

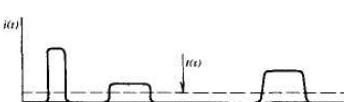
- 1. **Токовый режим** - измерение среднего тока (интенсивность излучения) \sim поток частиц.

Применяется: если не важна информация о точном времени регистрации.

Преимущественно дозиметрия, мониторирование интенсивности пучков

Средний ток:

$$I_0 = rQ = r \frac{E}{W} q$$



$$I(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t i(t') dt'$$

r – число событий в ед. времени

$Q = Eq/W$ – величина образованного заряда на одно событие

E – средняя энергия, выделяемая при единичном взаимодействии

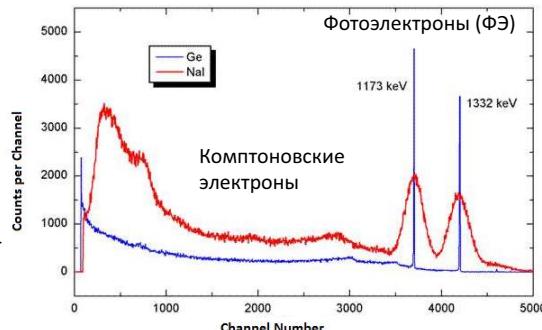
W – средняя энергия, необходимая для образования электрон-ионной пары

$q = 1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл заряд электрона

Функция отклика

Функция отклика (амплитуда) – характеристический амплитудный спектр, получаемый на данном детекторе при регистрации данного вида излучения.

Определяется конструкцией детектора, в том числе и внутренними взаимодействиями, которые сопровождают захват частицы: (К. рассеяние электронов, тормозное излучение)



Источник Co-60
 NaI: R=8-9% - низкий атомный номер Z: КР сравнило с ФЭ
 Ge: R=0.1% - ФЭ доминирует

$$PH(E) = \int S(E')R(E, E')dE'$$

$R(E, E')$ - функция отклика детектора для излучения энергии E'

$S(E')$ - спектр, регистрируемого излучения

Фактор Фано

Если флюктуации величины сигнала $H_0 = NK$ связаны только со «статистикой», то

N – число носителей зарядов
 K – коэффициент пропорциональности

«Пуассоновский предел»: N \uparrow R \downarrow

Энергетическое разрешение тем выше чем больше носителей заряда на единицу поглощенной энергии

Однако на практике R может быть в несколько раз меньше: **процессы образования первичных зарядов не являются независимыми**. В чистом виде статистика Пуассона не годится!

$$Fano = \frac{\text{Observed statistics (N)}}{\text{Poisson statistics (N)}}$$

$$R_{real} = \frac{FWHM}{H_0} = \frac{2.35K\sqrt{N}\sqrt{F}}{KN} = 2.35\sqrt{\frac{F}{N}} = 2.35\sqrt{\frac{Fw}{H_0}}$$

F – фактор Фано ($F < 1$): F=0.06(п/п), F=0.17(аргон, неон), $F \approx 1$ (сцинтиллятор)
 w – средняя энергия на образование e/i пары

Сравнение счетного и токового режима работы

Счетный режим:

- сигнал от каждого события обрабатывается отдельно
- позволяет определять скорость, время, энергию, координату каждой частицы в «живом времени»
- определять тип частицы (форма импульса, амплитуда...)
- ограничено мертвым временем системы «детектор + электроника»

Токовый режим:

- сигналы событий складываются, образуется общий сигнал
- вся информация об отдельных взаимодействиях теряется
- суммарный собираемый заряд пропорционален энергии потерянной частицами в детекторе – возможно измерять дозу(интенсивность) облучения
- Не ограничено мертвым временем электроники, поэтому можно использовать при высоких загрузках

Амплитудные характеристики

Дифференциальное распределение амплитуд – амплитудный спектр

$$\frac{dN}{dH} = f(H)$$

В **идеальном случае** при поглощении моноэнергетического излучения в детекторе распределение амплитуд имеет вид δ -функции.

На практике обычно Гауссиан:

$$f(H) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(H-H_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$R = \frac{\Delta H}{H_0} = \frac{2.355\sigma}{H_0}$$

Амплитудный спектр



$$\Delta H_{total}^2 = \Delta H_{stat}^2 + \Delta H_{noise}^2 + \Delta H_{drift}^2 + \dots$$

Источники флюктуаций:

- статистика при образовании e/i пар
- стабильность характеристик детекторной системы
- шум детектора/электроники

Эффективность регистрации

Эффективность поглощения (квантовая эффективность) – вероятность поглощения частицы в детекторе - **Вероятность взаимодействия падающего излучения с веществом детектора**

Собственная эффективность регистрации детектора – отношение числа зарегистрированных частиц (N) к числу пришедших частиц (N_0) :

$$\epsilon = N/N_0 < 1$$

Влияющие факторы:

- 1) Вероятность поглощения частицы в детекторе
- 2) Количество образованных свободных зарядов
- 3) Эффективность сбора образованных носителей зарядов в детекторе
- 4) Пороги электронных систем при обработке сигналов (сигнал/шум)
- 5) Мертвое время детектора и электронной системы (вероятность просчетов событий)

Геометрическая эффективность :

$$\epsilon_{\text{геом}} = \Omega / 4\pi$$

Абсолютная эффективность :

$$\epsilon = (\text{Число зарегистрированных}) / (\text{число излученных}) = \epsilon \times \epsilon_{\text{геом}}$$

Детектируемая квантовая эффективность (DQE) – отношение (сигнал/шум) на выходе детектора с (сигнал/шум) на входе детектора

$$DQE = \frac{(S/N)_{\text{out}}^2}{(S/N)_{\text{in}}^2}$$

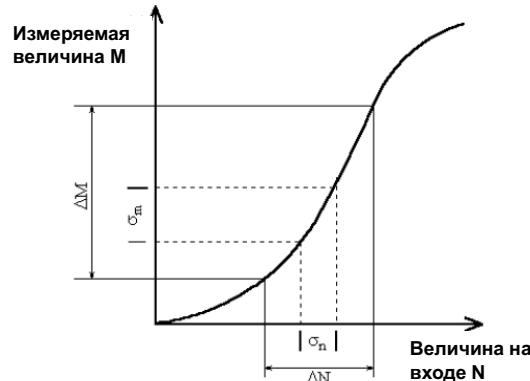
$$S/N \equiv SNR = M/\sigma$$

- Отношение «сигнал/шум» - отношение среднего измеряемой величины к стандартному отклонению

SNR_{in} : статистический характер (Пуассоновское распред.)

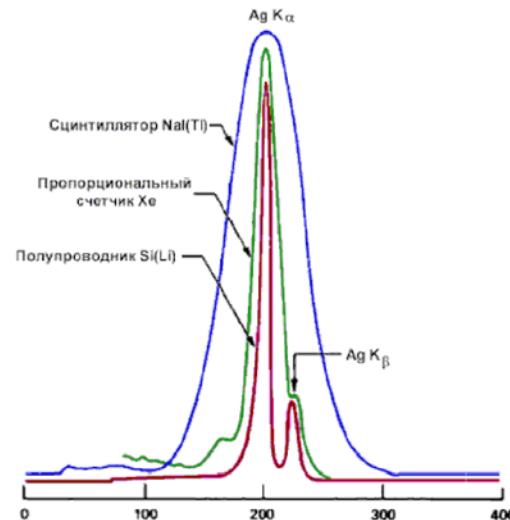
SNR_{out} : статистика + собственный шум детектора + шум электроники + мертвое время

$$\begin{aligned} SNR_{\text{in}} &= \frac{\Delta N}{\sigma_n} \\ SNR_{\text{out}} &= \frac{\Delta M}{\sigma_m} \\ DQE &= \frac{(SNR_{\text{out}})^2}{(SNR_{\text{in}})^2} \\ &= \frac{(\Delta M)^2 / \sigma_m^2}{(\Delta N)^2 / \sigma_n^2} \end{aligned}$$



Спектры К-линий серебра от источника ^{109}Cd , измеренные с помощью

- 1) детектор на основе неорганического сцинтиллятора NaI(Tl)
- 2) пропорциональный счетчик, заполненный газом Xe
- 3) Полупроводниковый детектор Si(Li)

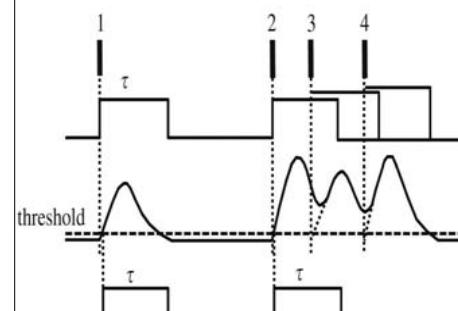


Мертвое время детектора и электронной системы

При регистрации отдельных импульсов различают две основные модели:

$$\begin{aligned} \text{В системе (1): } m_1 &= n * \exp(-n\tau) \\ (2): \quad m_2 &= n / (1+n\tau) \\ \text{При } n \ll 1 / \tau: \quad m_1 &\approx m_2 \approx n(1-n\tau) \end{aligned}$$

- 1) Д. с продлеваемым мертвым временем (τ)



- 2) Д. с непротягивающимся м.вр.



Пример оценки DQE детектора фотонов

Пусть **детектор фотонов** имеет площадь регистрации $A=0.75 \text{ см}^2$, эффективность конверсии фотонов $\epsilon=0.8$ (соб/фотон).

Темновой счет детектора обусловлен

- 1) собственным шумом детектора $\sigma_D^2 = 0.1 \text{ соб/сек} \sim T$ – времени регистрации
- 2) шумом считывающей электроники $\sigma_R^2 = 10 \text{ соб}$ (постоянный уровень)

Найдем DQE, если поток частиц $F = 5 \text{ фотон}/\text{см}^2/\text{с}$, время экспозиции $T=1 \text{ мин.}$

Сигнал/шум на входе

Входной сигнал – число фотонов приходящих на детектор:

$$S_{in} = q = FAT = 5 * 0.75 * 60 = 225 \text{ фотонов}$$

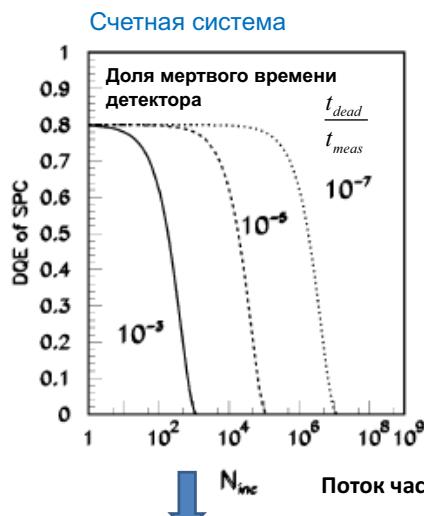
Входной шум - разброс в интенсивности потока фотонов (стандартная ошибка из распределения Пуассона):

$$N_{in} = \sqrt{q} = 15 \text{ фотонов}$$

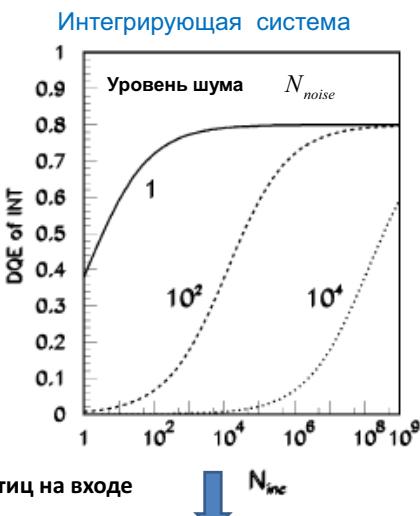
Тогда

$$SRN_{in} = \left(\frac{S_{in}}{N_{in}} \right) = 15$$

Детектируемая квантовая эффективность для счетных и интегрирующих систем регистрации

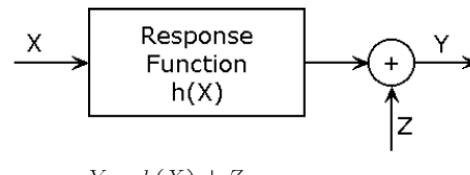


С уменьшением мертвого времени, доступны более высокие интенсивности



С ростом потока частиц вклад шума снижается

Пропорциональное усиление сигнала



$h(x)$ is a known detector response function

Z is an independent random variable with a known probability distribution.

Input Signal = $E[N] = q$

Input Noise = $\sigma_n = \sqrt{q}$

Output Signal = $E[M] = \frac{gq}{g^2q + \sigma_z^2}$

Output Noise = $\sigma_m = \sqrt{g^2q + \sigma_z^2}$

$$\begin{aligned} DQE &= \frac{(\Delta M)^2 / \sigma_m^2}{(\Delta N)^2 / \sigma_n^2} \\ &= \frac{(gq)^2 / (g^2q + \sigma_z^2)}{(q / \sqrt{q})^2} \\ &= \frac{g^2q}{g^2q + \sigma_z^2} = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_z^2}{g^2q}} \end{aligned}$$

Сигнал/шум на выходе

Выходной сигнал – число зарегистрированных фотонов детектором

$$S_{out} = q\epsilon = 180 \text{ фотонов}$$

Выходной шум состоит из трех компонент – разброс числа зарегистрированных фотонов, шум регистрирующей электроники, темновой шум детектора

$$(N_{out})^2 = q\epsilon + \sigma_D^2 T + \sigma_R^2 = 180 + 0.1 * 60 + 10^2 = 286$$

$$N_{out} = 16.9 \text{ фотонов}$$

Тогда

$$SRN_{out} = \left(\frac{S_{out}}{N_{out}} \right) = 10.64$$

Получаем DQE

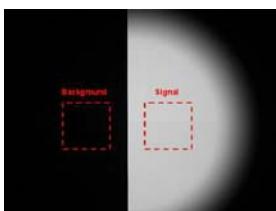
$$DQE = \left(\frac{SRN_{out}}{SRN_{in}} \right)^2 = \left(\frac{10.64}{15} \right)^2 = 0.5$$

При работе с изображениями часто обрабатывают какую-то область «интересов»

Для нахождения среднего сигнала и среднего по фону для фитирования выбранных данных в области (пиксель-интенсивность) применяют полином 2-го порядка

$$f_i = \sum_{j=0}^m \sum_{i=1}^n a_j x_i^j$$

m – порядок полинома
 n – число строк
 a_j – коэффициенты полинома
 x_i – значение сигнала



Из системы уравнений находятся f_i

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum f_i x_i \\ \sum f_i x_i^2 \end{bmatrix}$$

Тогда средний сигнал по области определяются как

$$\langle Sig \rangle = \mu_{sig} - \mu_{bkg} \quad \mu_{sig} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - f_i)}{n} \quad \mu_{bkg} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - f_i)}{n}$$

μ_{sig} – среднее значение сигнала

M_{bkg} – среднее значение фона

n – число строк

X_i – значение сигнала/фона на строке i

Пример искусственного увеличения динамического диапазона
HDR-фотография

Сигнал/шум (SNR) в цифровых и аналоговых системах отображения

Отношение «сигнал/шум» в системах отображения характеризуют чувствительность системы отображения, измеряется в дБ (мощности).

$$SNR = \frac{\mu_{sig}}{\sigma_{bg}}$$

SNR – отношение среднего значения сигнала от стандартного отклонения фона

Для высококонтрастных изображений часто принимают $\sigma_{bg} = 0$, тогда

$$SNR = \frac{\mu_{sig}}{\sigma_{sig}}$$

где σ_{sig} – стандартное отклонение сигнала

Динамический диапазон (сигнал) или «контраст» – отношение амплитуды максимальной амплитуды сигнала S, которую можно измерить до входа в режим насыщения к уровню шума N (генерируемого детектором при отсутствии внешнего излучения)
 $D=(S/N)$ - отношение «сигнал/шум»

Пример: CCD – charge coupled device:

Уровень насыщения одной чувствительной ячейки $S \sim 3 \cdot 10^5$ е,

Уровень собственного шума $N \sim 10$ е

$$\Rightarrow D=S/N=3 \cdot 10^4$$

Берем CCD для фотонов:

1) Для гамма-квантов с энергией 10 кэВ:

при поглощении 1 кванта образуются ~ 3000 е
 Событий с меньшими амплитудами нет!

$$\Rightarrow D=3 \cdot 10^5 \text{ е} / 3 \cdot 10^3 \text{ е} = 100$$

2) Для видимого света:

$$1 \text{ квант} \sim 1 \text{ е} \quad \Rightarrow \quad D=3 \cdot 10^5 \text{ е} / 1 \text{ е} = 3 \cdot 10^4$$

Координатное разрешение

Координатное разрешение – способность детектора пространственно разделять зарегистрированные события

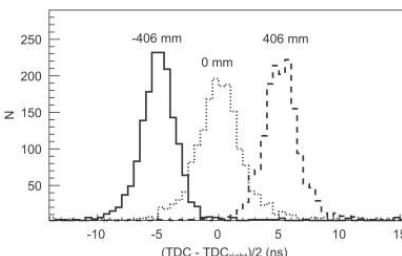
Без координатной чувствительности – счетчики (сенсоры)

При исследовании рассеяния наиболее часто применяются 1, 2 – координатные системы.

В физике высоких энергий для восстановления треков высокоэнергетических частиц применяют 3D-трековые системы.

Зависит от многих факторов:

- 1) Детектирующая среда и ее состав
- 2) Пробеги ионизирующих частиц внутри детектора (вторичное излучение)
- 3) Диффузия зарядов при их дрейфе к электродам
- 4) Параметров регистрируемого сигнала и методов восстановления координаты
- 5) и др.



Два близко лежащих пика пространственно разделяются, если они удалены друг от друга на величину (FWHM) – ширина единичного пика на полувысоте

Часто FWHM зависит от координаты и угла входа частицы в детектор $f(x, \theta)$

Последний эффект – эффект параллакса

Детектор облучен в трех позициях

Выводы по лекции 2.

• Нейтроны и СИ (фотоны) необходимо преобразовать в «детектируемые» вторичные частицы:

-СИ: $E < 100$ кэВ. Преобладающие эффекты: ФЭ, КР сопровождаются выходом e^- и вторичных фотонов. Свойства материала определяют характеристики детектора и эффективность его использования для регистрации СИ данной энергии

- нейтроны – ядерные реакции. Вторичное излучение: p, γ, α , осколки деления.

Число применяемых конверторов нейtronов ограничено эффективностью их применения, возможностью достижения комплекса требуемых характеристик детектора

• Основные характеристики детектора: эффективность регистрации, амплитудное разрешение, пространственное разрешение, загрузочная способность и др. – есть уникальное сочетание для каждого типа детектора (будем рассматривать дальше)

Загрузочная способность

• **Локальная** – максимальная плотность потока данного излучения, которую способен регистрировать детектор (при уровне просчетов не более 10%):
частец/см²/с

«Физические» ограничения – скорости дрейфа носителей заряда в рабочем веществе детектора (п/п, газ. дет.), время «высвечивания» (сцинтиллятор)

Конструктивные факторы: расстояние анод-катод

цилиндрические газовые счетчики: мм – см 10^3 соб/мм²/с

микроструктурные детекторы: дес-сотни мкм 10^6 соб/мм²/с

• **Интегральная** – максимальная интенсивность излучения, которую может регистрировать детектор по всей площади (10% просчетов): частец/с

Ограничена методом считывания сигналов с детектора:

- поканальный съем сигналов: быстро, но много каналов электроники и дорого
- интерполяционные методы (съем сигналов на RC-/LC-цепочки): медленно (до неск. МГц/детектор), мало каналов электроники, дешево

Конвертор и координатное разрешение

Основные конверторы нейтронов и их параметры при взаимодействии с нейтронами (1.8 Å). Приведены сечения реакций, энергии и пробеги продуктов реакций, а также длина свободного пробега нейтронов (1.8 Å) в этих веществах

Изотоп	Агрегатное состояние	Сечение реакции, бн	Длина своб. проб.	Продукты реакции и их энергии (кэВ)	Пробеги продуктов реакции
³ He	газ	5330	атм.	$p: 573$	$T: 191$
⁶ Li	тв.	940	230 мкм	$T: 2727$	$\alpha: 2055$
¹⁰ B	тв.	3840	20 мкм	$\alpha: 1472$	$^{7}\text{Li}: 840$
¹⁰ BF ₃	газ	3840	атм.	$\alpha: 1472$	$^{7}\text{Li}: 840$
¹⁵⁵ Gd	тв.	49000	6.7 мкм	Конв. электроны: $39 \div 199$	12 мкм
¹⁵⁷ Gd	тв.	254000	1.3 мкм	Конв. электроны: $29 \div 182$	12 мкм

$$\rho_{\text{тв}} / \rho_{\text{газ}} \sim 10^3$$

Предлагаемые темы докладов:

- 1) Вторичные процессы в газах – краткий обзор
 - упр/неупр. столкновения
 - образование/гибель заряженных частиц

Лит-ра: Райзера Ю.П., Физика газового разряда. Учебное руководство. М. Наука. 1987г. 592с
- 2) Микроструктурные газовые детекторы (например GEM) – краткий обзор и применение в экспериментах(COMPASS, LHCb, TOTEM, PHENIX): фотоны, нейтроны, быстрые частицы
Лит-ра: интернет (литература в основном на англ.языке)
- 3) Механизмы старения газоразрядных детекторов
Лит-ра: подборка по email + интернет (литература на англ.языке)